

2SB957(L), 2SB957(S)

シリコン PNP エピタキシャル形

SILICON PNP EPITAXIAL

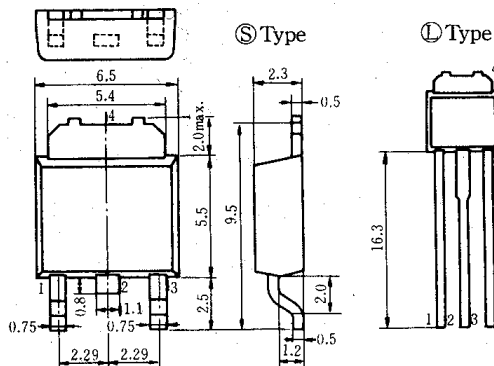
低周波電力増幅用

LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER

2SD1281(L), 2SD1281(S)とコンプリメンタリペア

Complementary pair with

2SD1281(L) and 2SD1281(S)



1. ベース: Base
 2. コレクタ: Collector
 3. エミッタ: Emitter
 4. コレクタ: Collector
- (Dimensions in mm)

(DPAK)

■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

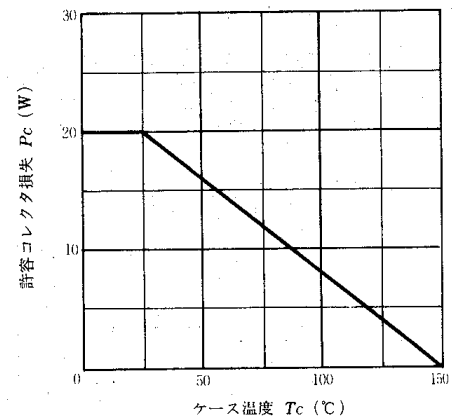
項目	Symbol	2SB957(L), 2SB957(S)	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	-100	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	-60	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-2	A
せん頭コレクタ電流	$i_{C(\text{peak})}$	-3	A
許容コレクタ損失	P_C^*	20	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55~+150	$^\circ\text{C}$

* $T_c=25^\circ\text{C}$ における許容値

* Value at $T_c=25^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失のケース温度による変化

MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$	$I_C = -1\text{mA}, I_E = 0$	-100	-	-	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -10\text{mA}, R_{BE} = \infty$	-60	-	-	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = -1\text{mA}, I_C = 0$	-5	-	-	V
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -80\text{V}, I_E = 0$	-	-	-1	μA
エミッタ遮断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5\text{V}, I_C = 0$	-	-	-1	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}^*	$V_{CE} = -5\text{V}, I_C = -0.5\text{A}^{**}$	60	-	200	
直流電流増幅率	h_{FE2}	$V_{CE} = -5\text{V}, I_C = -2\text{A}^{**}$	40	-	-	
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CE} = -5\text{V}, I_C = -2\text{A}^{**}$	-	-	-1.4	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(\text{sat})}$	$I_C = -1.5\text{A}, I_B = -0.15\text{A}^{**}$	-	-0.6	-1.0	V
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE} = -5\text{V}, I_C = -0.5\text{A}^{**}$	-	250	-	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10\text{V}, I_E = 0, f = 1\text{MHz}$	-	40	-	pF

* 2SB957(L), 2SB957(S)は、 h_{FE1} の値により下記のように2区分し、現品に表示してあります。

* The 2SB957(L) and 2SB957(S) are grouped by h_{FE1} as follows.

**パルス測定

** Pulse Test

B	C
60~120	100~200

■ 各特性曲線は2SB874参照

See characteristic curves of 2SB874